

多维科技推出高灵敏度无源磁记忆 TMR 磁开关传感器

先进的 TMR 技术为高性能工业类应用实现无需供电电源的磁记忆特性

中国江苏省张家港市 2019 年 4 月 13 日电 江苏多维科技有限公司日前推出带无源磁记忆功能的低功耗双极锁存开关传感器 TMR1215，它是包括电梯双稳开关、非接触磁旋钮、磁翻板液位计、固态开关、速度检测等众多工业类应用的理想选择。



TMR1215 双极锁存磁记忆开关传感器的主要特点：

- 隧道磁电阻 (TMR) 技术
- 无需工作电源，记录磁场极性变化
- 开启点/释放点 35Gs
- 1.5 μ A 低功耗
- 1kHz 高频率响应
- 双极锁存型磁开关
- 宽工作电压范围
- 卓越的温度稳定性
- 优越的抗外磁场性能

TMR1212/TMR1213/TMR1215 是为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的无源磁记忆双极锁存 TMR 磁开关传感器系列产品。与常规的磁开关相比，TMR1212/TMR1213/TMR1215 带有磁记忆功能，在掉电情况下依然可以探测磁场极性变化，并存储在磁存储单元中，上电后可以立刻读取最近一次的磁场极性状态。

型号	TMR1215	TMR1212	TMR1213
开关类型	双极锁存	双极锁存	双极锁存
电压 (V)	1.8~5.5	1.8~5.5	1.8~5.5
功耗 (μ A)	1.5	1.5	1.5
频响 (Hz)	1000	1000	1000
工作方式	连续供电	连续供电	连续供电
敏感方向	X 轴	X 轴	X 轴
开启点 (Gs)	35	45	75
释放点 (Gs)	-35	-45	-75
输出	CMOS	CMOS	CMOS
封装形式	SOT23-3, TO92S	SOT23-3, TO92S	SOT23-3, TO92S

多维科技的**磁传感器芯片产品系列**包括 TMR 磁开关传感器芯片、TMR 线性磁场传感器芯片、TMR 磁性角度传感器芯片、TMR 磁性齿轮传感器芯片，**磁传感器模组产品系列**包括 TMR 磁特征检测传感器模组（金融磁头）、TMR 磁图像传感器模组、TMR 齿轮编码器模组、TMR 旋转编码器模组、TMR 电流传感器模组、TMR 液位传感器模组、TMR 磁强计模组、AGV 磁导航传感器模组、非接触式线性位移传感器模组等。

多维科技（MDT®）简介

MDT 创立于 2010 年，总部设在中国江苏省张家港，在中国北京、成都、宁波、日本大阪和美国加利福尼亚州圣何塞设有分公司。MDT 拥有多项独特的专利技术和先进的制造能力，可批量生产高性能、低成本的磁传感器以满足严格的应用需求。多维科技的核心管理团队由磁传感器技术和工程服务领域的业内精英和资深专家组成。在核心团队的带领下，MDT 致力于为客户带来更多附加值，并确保他们的成功。有关 MDT 详情，请访问：www.dowaytech.com。

媒体联系人

美国，刘劲峰，电邮：jinfeng.liu@dowaytech.com

电话：+86-189-3612-1156（中国）

中国，魏继烈，电邮：kevin.wei@dowaytech.com

电话：+86-189-3612-1160（中国）

技术支持

李东风，电邮：dongfeng.li@dowaytech.com

电话：+86-189-3612-1167

消息来源：江苏多维科技有限公司